

	<h2>SQJ479EP-T1_GE3</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: SQJ479EP-T1_GE3</p> <p>Hersteller / Marke: Vishay / Siliconix</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET P-CH 80V 32A SO8</p> <p>Datenblätter:  SQJ479EP-T1_GE3.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	









Spezifikationen

Teilenummer	SQJ479EP-T1_GE3
Hersteller	Vishay / Siliconix
Beschreibung	MOSFET P-CH 80V 32A SO8
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2.5V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PowerPAK® SO-8
Serie	Automotive, AEC-Q101, TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	33 mOhm @ 10A, 10V
Verlustleistung (max)	68W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	PowerPAK® SO-8
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	4500pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	150nC @ 10V
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	80V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	32A (Tc)

SQJ479EP-T1_GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SQJ479EP-T1_GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SQJ479EP-T1_GE3 Vishay / Siliconix mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SQJ479EP-T1_GE3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SQJ474EP-T1_GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 100V 26A SO8</p>	 <p>SQJ479EP-T1_GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 80V 32A POWERPAKSO-8</p>	 <p>SQJ486EP-T1_GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 75V POWERPAK SO8L</p>	 <p>SQJ481EP-T1_GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CHAN 80V POWERPAK SO-8L</p>
 <p>SQJ474EP-T1_GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 100V 26A POWERPAKSO</p>	 <p>SQJ476EP-T1_GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 100V 23A SO8</p>	 <p>SQJ488EP-T1_GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 100V POWERPAK SO8L</p>	 <p>SQJ486EP-T1_GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 75V POWERPAK SO8L</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

SQJ479EP-T1_GE3 Vishay / Siliconix	SQJ479EP-T1_GE3 Datenblatt	SQJ479EP-T1_GE3-Datenblätter	SQJ479EP-T1_GE3 PDF	Vishay / Siliconix SQJ479EP-T1_GE3
SQJ479EP-T1_GE3 Electronic	SQJ479EP-T1_GE3-Komponenten	SQJ479EP-T1_GE3-Verteiler	SQJ479EP-T1_GE3-Bild	SQJ479EP-T1_GE3-Teil
SQJ479EP-T1_GE3 Preis	SQJ479EP-T1_GE3 Hersteller	SQJ479EP-T1_GE3 Bild	SQJ479EP-T1_GE3 Aktie	SQJ479EP-T1_GE3 Inventar
SQJ479EP-T1_GE3 Neu	SQJ479EP-T1_GE3 Original	SQJ479EP-T1_GE3 garantiert	SQJ479EP-T1_GE3 RFQ	SQJ479EP-T1_GE3 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited